

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 56-088329

(43)Date of publication of application : 17.07.1981

(51)Int.Cl.

H01L 21/60

(21)Application number : 54-166147 (71)Applicant : TANAKA DENSHI KOGYO KK

(22)Date of filing : 19.12.1979 (72)Inventor : HAYASHI SHOZO
TOMIYAMA SUSUMU

(54) GOLD WIRE FOR BONDING SEMICONDUCTOR ELEMENT AND SEMICONDUCTOR ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain gold wire whose bonding property is excellent by the inclusion of specified amounts of Ag, Be, Ca, Fe, and Mg, in addition to Au.

CONSTITUTION: By the inclusion of 2W80ppm of Ag, 0.5W30ppm of Be, 1W20ppm of Ca, 0.5W50ppm of Fe, and 0.5W50ppm of Mg in weight ppm indications, in addition to Au, the elements cooperate together in said composition range, the balance in the Au wire itself is maintained, and the excellent bonding property is indicated. If the total amount of the added elements is made to be 4.5W230wt. ppm, the secular softening of the gold wire and unstable gold ball configuration are not generated. Although Ti, Cu, Si, Sn, Bi, Mn, Pb, Ni, Cr, Co, Al, and Pd are readily mixed naturally or in the manufacturing process, the balance in the gold wire itself is not hampered if the maximum weight ppm is less than 30. However, if more than 5wt. ppm of Cd, Zn, Sb, As, B, and the like is mixed, the characteristics of the gold wire tend to decrease. In this constitution, can be obtained the bonding wire of the Au alloy which is hard to be subjected to the thermal effect, and has the thin bonding layer after the bonding and the large bonding strength.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

PAT-NO: JP356088329A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56088329 A

TITLE: GOLD WIRE FOR BONDING SEMICONDUCTOR ELEMENT AND SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUBN-DATE: July 17, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HAYASHI, SHOZO
TOMIYAMA, SUSUMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TANAKA DENSHI KOGYO KK	N/A

APPL-NO: JP54166147

APPL-DATE: December 19, 1979

INT-CL (IPC): H01L021/60

US-CL-CURRENT: 438/100, 438/FOR.364

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain gold wire whose bonding property is excellent by the inclusion of specified amounts of Ag, Be, Ca, Fe, and Mg, in addition to Au.

CONSTITUTION: By the inclusion of 2~80ppm of Ag, 0.5~30ppm of Be, 1~20ppm of Ca, 0.5~50ppm of Fe, and 0.5~50ppm of Mg in weight ppm indications, in addition to Au, the elements cooperate together in said composition range, the balance in the Au wire itself is maintained, and the excellent bonding property is indicated. If the total amount of the added elements is made to be 4.5~230wt. ppm, the secular softening of the gold wire and unstable gold ball configuration are not generated. Although Ti, Cu, Si, Sn, Bi, Mn, Pb, Ni, Cr, Co, Al, and Pd are readily mixed naturally or in the manufacturing process, the balance in the gold wire itself is not hampered if the maximum weight ppm is less than 30. However, if more than 5wt. ppm of Cd, Zn, Sb, As, B, and the like is mixed, the characteristics of the gold wire tend to decrease. In this constitution, can be obtained the bonding wire of the Au alloy which is hard to be subjected to the thermal effect, and has the thin bonding layer after the bonding and the large bonding strength.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭56—88329

⑩ Int. Cl.³
H 01 L 21/60

識別記号

府内整理番号
6851—5F

⑬ 公開 昭和56年(1981)7月17日

発明の数 2
審査請求 未請求

(全 4 頁)

④ 半導体素子のポンディング用金線及び半導体
素子

② 特 願 昭54—166147

② 出 願 昭54(1979)12月19日

⑦ 発明者 林正蔵

所沢市上新井1642—37

⑦ 発明者 富山進

三鷹市下連雀6—6—20

⑦ 出願人 田中電子工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2丁

目14番地3

⑦ 代理人 弁理士 早川政名 外1名

明細書

1. 発明の名称

半導体素子のポンディング用金線及び半導体素子

2. 特許請求の範囲

(1) 鋼 2～80重量 ppm、ベリリウム 0.5～30重量 ppm、カルシニューム 1～20重量 ppm、鉄 0.5～50重量 ppm、マグネシウム 0.5～50重量 ppmを含有し、シリカ並であることを特徴とする半導体素子のポンディング用金線。

(2) 特許請求の範囲第1項に記載する半導体素子のポンディング用金線がチタン、鉄、シリコン、銅、ビスマス、マンガン、錫、ニッケル、クロム、コバルト、アルミニウム、バラシウムの一組又は複数を含有し、その組合せが30重量 ppm以上であることを特徴とする半導体素子。

(3) 特許請求の範囲第1項又は第2項に記載する半導体素子のポンディング用金線が上記元素以外の不純物元素を含有し、その組合せが5重量 ppm以上であることを特徴とする半導体素子。

とを特徴とするポンディング用金線。

(4) シリコンチップ電極と、鋼 2～80重量 ppm、カルシニューム 1～20重量 ppm、ベリリウム 0.5～30重量 ppm、鉄 0.5～50重量 ppm、マグネシウム 0.5～50重量 ppm、残りを並としたポンディング用金線との接触部から成る半導体素子。

(5) 特許請求の範囲第4項に記載する半導体素子のポンディング用金線がチタン、鉄、シリコン、銅、ビスマス、マンガン、錫、ニッケル、クロム、コバルト、アルミニウム、バラシウムの一組又は複数を含有し、その組合せが30重量 ppm以下であることを特徴とする半導体素子。

(6) 特許請求の範囲第4項又は第5項に記載する半導体素子のポンディング用金線が上記元素以外の不純物元素を含有し、その組合せが5重量 ppm以下であることを特徴とする半導体素子。

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体のナップ電極と外部リード部とを接続するためICを使用するワイヤポンディング

ク用金線及びその半導体素子に関する。

金は耐食性があり、延展性が良くポンディング性に優れていることから、一般に金を主成分とした金合金が半導体素子のポンディング用金線として知られている。

従来、このような金合金からなるポンディング用金線を酸水素炎又は燃焼的に溶解し、その際にできる金ポールを押し潰して150～300 μの加熱状態におかれている半導体のチップ電極と外部リード部に手動式や自動式のポンディングマシンを用いて接続していた。

しかるに従来から使用されている金線は直径50 μ以下の中継にすると、引張強さが弱く、機械加工中に断線したり、あるいはポンディング作業中に断線を起したり、さらにポンディング金線を溶断したときにポンディング金線本来の繊維状結晶組織が失なわれて母結晶による結晶粒の粗大化を起しもろくなったり、あるいは金ポールの形状が一定せずポンディング後の接合

強度が低下したりするなどの欠点があつた。

又、上記のように150～300 μの温度で熱圧着するため、ポンディング金線が軟化し、チップ電極と外部リード部を接続するポンディング金線のループ形状がたるみを生じて外部リード部をショートしたり、さらに樹脂をモールドする場合、ポンディング金線が軟化によって膨らみショートや断線の原因となつたり、あるいは絶縁的に軟化して引張強さが低下し断線したりする欠点があつた。

そこで本発明者は従来のポンディング金線を分析したところ、金合金の金の純度が99.99質量%以上であり、金以外の元素の合計重量が100重量ppm以下である場合が最も多かつた。

金以外の元素の成分や含有量は、金の産出地の自然的影響や必要上故意に添加する人為的影響により各々異なるものの、いずれも並に特有の元素を精製せずに残して、又は人為的に添加してポンディング性を向上させようとするもので

- 3 -

- 4 -

あつた。例えば銅元素を含有せしめた金合金を使用したり、銀と銅の合計重量を規定して含有せしめた金合金を使用したり、カルシウムやゲルマニウムや鉛等を含有せしめた金合金を使用したりしてポンディング性を向上しようとしていた。

しかしながら、ポンディング金線が必要とする要點には、①引張強さが大きいこと、②耐溶断性が大きいこと、③結晶軟化が少ないこと、④金ポールの形状が真球に近く且つ一定していること、⑤ポンディング後の接合強度が大きいことの五要素が最小限必要であり、特にシリコンチップ電極の半導体素子の場合にはポンディング後シリコンの半導体特性に悪影響を与えないために前記の⑤要素が炭水される。このように多くの要素が必要とされるため従来の金合金では、これらすべての要素を満足させる金線を得ることができなかつた。

そこで本発明者は以上従来構成に並み、極々

の実験及び測定をくり返し行なつたところ、上記五要素を全て満足するポンディング金線は、金以外の元素を単に添加したりするのでは得ることができず、特定元素及びそれらの含有量による金合金自体のバランスによらなければならぬことを見出したのである。

すなわち、単純な金以外の元素の添加では金以外の元素のバランスが金の産出地や精製等の自然的影響により左右され、前記①～⑤の五要素を同時に満足させることができないからである。

而して本発明の目的は上記①～⑤の五要素を満足してポンディング性に優れた金線及びポンディング後の半導体特性に優れた半導体素子を提供することにある。

前記本発明金線は、銀(Ag)2～80重量ppm、ペリリウム(Be)0.5～30重量ppm、カルシウム(Ca)1～20重量ppm、鉄(Fe)0.5～50重量ppm、マグネシウム(Mg)0.5～50重量ppmを含有し、残りが金(Au)であることを特徴とし、又本発明

半導体素子はシリコンチップ電極と、銀(Ag)2~80重量 ppm、ベリリウム(Be) 0.5~30重量 ppm、カルシウム(Ca) 1~20重量 ppm、鉄(Fe) 0.5~50重量 ppm、マグネシウム(Mg) 0.5~50重量 ppm強りを金としたポンディング用金線との接合体から成ることを特徴とする。

上記並に含有される元素、すなわち銀、ベリリウム、カルシウム、鉄及びマグネシウム(第一元素群とする)は前記組成範囲で共存して金線自体のバランスを保持し前記①~⑤の五要素を満す。

すなわち銀はその含有量が2重量 ppm以下では金線が絶時軟化を起し、80重量 ppm以上ではポンディング後の接合強度が低下する。

ベリリウムはその含有量が0.5重量 ppm以下では引張強度が低下し30重量 ppm以上では粒界破壊を起した。

カルシウムはその含有量が1重量 ppm以下では高應力の引張強度が低下し、20重量 ppm以上

では塑性が失われる。

鉄はその含有量が0.5重量 ppm以下では引張強さが低下し、50重量 ppm以上ではポンティング時金線表面に酸化被膜が生成し、ポンディング後の接合強度が低下する。

マグネシウムはその含有量が0.5重量 ppm以下では引張強さが低下し、50重量 ppm以上では溶断時の金ホール形状が悪くなる。

上記組成範囲内であればポンディング性は維持できるが、好ましくは上記第一元素群の総含有量が4.5~230重量 ppmであるとよい。すなわち上記Au-Ag-Be-Ca-Fe-Mg合金が他の元素の影響を受けやすく量産した際に、その総含有量が4.5重量 ppm以下ではポンディング金線が絶時軟化を起しやすくなり、230重量 ppm以上では金ホールの形状が不安定になりやすく、またポンディング後の接合強度が低下しやすくなる。

上記金線、Au-Ag-Be-Ca-Fe-Mg合金

- 7 -

- 8 -

には前記①~⑤の五要素に影響を与えるにくい元素と影響を与えるやすい元素がある。

なぜなら上記Au-Ag-Be-Ca-Fe-Mg合金の組成範囲が重量 ppmのオーメーであるため、通常の金合金と異なり、特にポンディング金線として要求されるからである。

上記影響を与えるにくい元素(第二元素群とする)としてはチタン(Ti)、銅(Cu)、シリコン(Si)、錫(Sn)、ヒスマス(Bi)、マンガン(Mn)、鉛(Pb)、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、コバルト(Co)、アルミニウム(Al)、パラジウム(Pd)の各元素であり、これらの各元素は上記金線の五要素に対して一様に効き、最大30重量 ppmを越えなければ金線自体のバランスを崩さない。

上記第二元素群の各元素は自然的影響により又は製造の都合などの人為的影響により金線合金中に混入されやすい。

上記第一及び第二元素群以外の元素、すなわち金線に要求される五要素に影響を与えるやすい元

素(第三元素群とする)はカドミウム(Cd)、亜鉛(Zn)、アンチモン(Sb)、ヒソ(Ae)、ボロジ(B)等であつて、上記金線合金のバランスを崩すやすく、人為的影響により混入している場合でも精製などにより極力取り除かなければならぬ。

上記第三元素群がその総含有量で5重量 ppmを越えれば、量産したときに金線合金、Au-Ag-Be-Ca-Fe-Mg合金のバランスがくずれ金線の特性を低下しやすくなる。

上記組成範囲のAu-Ag-Be-Ca-Fe-Mg合金から成る金線はシリコンチップ電極に熱圧着法などで接着し一体として半導体素子が形成されるが、従来の金線に比し非常に好都合である。

すなわち、従来金線であれば、ポンディング時の熱影響で金線とシリコンチップ電極との接合層が厚くなり接合強度が低下するのに対し、本発明のバランスのとれたAu-Ag-Be-Ca-Fe-Mg合金からなる金線は熱影響を受け難くポン

- 9 -

- 10 -

ティング法も複合層が薄く接合強度が大きく、シリコン半導体特性が優れている。

以下に実施例を示す。

各試料はAu-Ag-Ba-Cu-Fe-Mg合金を熔融鍛造し、鍛引加工により直径25μmの複合ポンティング金網としたものである。

各試料の元素及びその含有量は次表(1)に示す通りであつて、その試料No.1～4は本発明の実施品、No.5～8は比較品を示す。

表 (1)

試料 番 号	第一元素組(重量ppm)					第二元素組(重量ppm)		第三元素組(重量ppm)	
	Au	Ag	Ba	Cu	Fe	Mg	元 素	總 計	
実 験 品	1	2	0.5	1	0.5	0.5	Cu<5, Si<5	<30	Zn<5
	2	10	30	3	1	1	Pd<5	<30	—
	3	20	15	2	3	15	Si<5, Pd<5	<30	Sn<5
	4	80	30	20	50	50	Bi<5, Sn<5	<30	Tl<5
比 較 品	5	90	20		20	60	Bi<5, Cu<5, Pb<5	<30	Cd<5
	6	2	0.2	1	0.5	0.5	Tl<5	<30	—
	7	90	40	5	35	30	Bi<5, Cr<5	<30	Zn<5
	8	70	10	5	3	20	Cu(20), Bi(20), Ni(5)	>30	Ti<5

上記各試料をもつて強磁的性質、その他の諸特性を測定した結果を表(2)に示す。

尚、表の⑤欄中の初期とは鍛引加工した直後の引張強さをいう。

表 (2)

試料 番 号	① 引張強さ(%) (伸び一定)		② 高温強度 (250℃保持)		③ 短時間化 (引張強さ)		④ 金属性 の形狀	⑤ ボンディング 後の接合強度 (kg)
	燃耗(%)	伸び(%)	燃耗(%)	伸び(%)	燃耗(%)	伸び(%)		
No.1	9.8	4	4.5	5	20	19.5	真円	5
No.2	12	4	6.5	4	21	21	真円	7
No.3	11	4	6	5	20	20	真円	8
No.4	15	4	11	3	22	22	真円	9
比 較 品 No.5	12	4	2	5	21	21	いびつ	2.5
No.6	6.5	4	2.5	4	19	10	真円	3
No.7	14	4	3	5	21	21	いびつ 酸化被膜	3
No.8	9	4	3	5	20	20	いびつ	3.5

上記表から明らかのように、本発明の実施品No.1～No.4がいずれも上記表(2)中の項目①～⑤を全て満足するのに対し、比較品No.5～No.8はいずれも項目①～⑤を全て満足するものはない。この項目①～⑤は前述したボンディング鍛に要

求される前記五要①～⑤に對応した特性を示すものである。

上記実施例であきらかのように、本発明によるバランスの保たれた組織は、ボンディング並鋼としての性能が優れており、かつ、シリコンチップ電極に密接して半導体として構成されたものは、接合強度が大きく半導体電子としての性能が優れていることがわかる。

よつて、本発明の目的を達成することができるのである。

特許出願人

山中電子工業株式会社

代理 人

早川 純



代理 人

早川 純

